

BN焼結体・セラミック基板(AlN, Al₂O₃, Si₃N₄)

BN焼結体

- 国内品と比較し、低価格・短納期・同等品質の窒化ホウ素焼成体。
- セッター、るつぼ、ノズル、絶縁碍子等さまざまな形状で製作可能。
- 粉末冶金、半導体製造装置用部品としての採用実績あり。

高熱衝撃性

高耐熱性

高耐食性

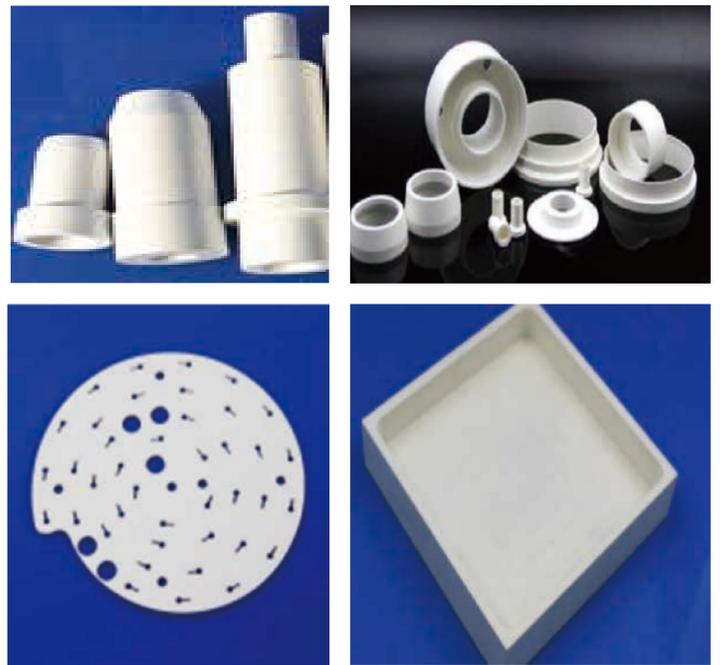
低い濡れ性
(対金属)

製作可能サイズ

角板 : 550x550x250mm

円板 : φ540x250mm

項目		ホットプレスBN		導電性BN
主要成分		BN 99%	BN 99.7%	BN+TiB ₂ +AlN
密度	g/cm ³	1.9~2.0	1.6~1.75	>3
曲げ強度	Mpa	30	18	>150
耐熱温度 (大気中/不活性中)	°C	900/2200	900/2200	900/2000
熱伝導率(常温)	W/mk	15	35	100
抵抗値	Ω.cm	>10 ¹⁴	>10 ¹⁴	300-2000 μ



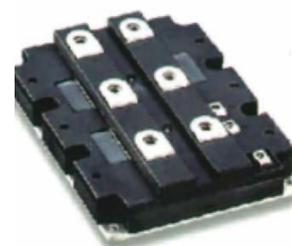
セラミック基板(AlN, Al₂O₃, Si₃N₄)

- AlN(窒化アルミニウム)、Al₂O₃(アルミナ)、Si₃N₄(窒化ケイ素)の様々な熱伝導率の放熱基板。
- 0.2mm~3.0mm等の厚みやLap研磨、鏡面研磨も可能。

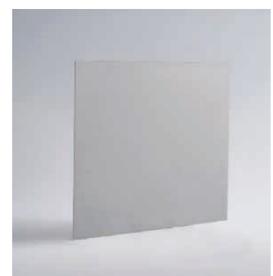
用途例

- IGBTモジュール基板 ●抵抗器の基板
- 水晶振動子のサブマウント

項目		Al ₂ O ₃	AlN	AlN	Si ₃ N ₄
熱伝導率	W/m·K	25	170	200	80
密度	gm/cc	3.7	3.3	3.26	3.2
曲げ強度	MPa	350	400	350	700
破壊強度	KV/mm	15	17	17	20
表面粗さ	Ra	0.6	0.6	0.6	0.8



IGBT module



商品の詳細は
こちら

